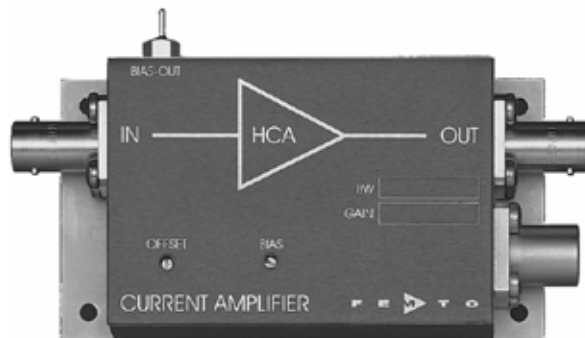


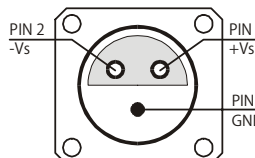
高速 電流アンプ

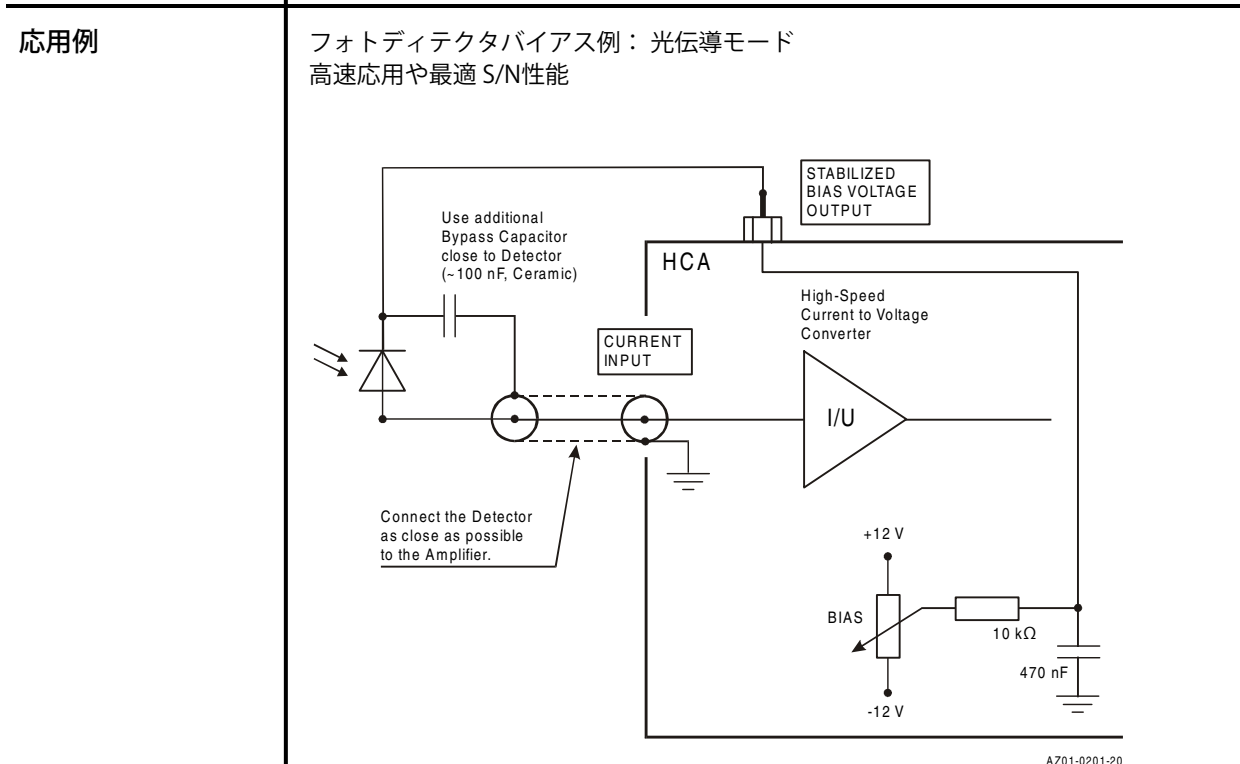


<p>特長</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ バンド幅、周波数応答性 - ディテクタ容量無依存 (1 nFまで) ・ 低ノイズ 3.5 pA/√Hz 等価入力ノイズ電流 ・ バンド幅 DC ~ 2 MHz ・ 固定トランスインピダンス (ゲイン) 1 x 10⁶ V/A ・ 瞬時高電圧保護 ± 3.5 kV (10 ns) 	
<p>応用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ フォトダイオード、光電子増倍管用アンプ ・ 分光 ・ チャージアンプ ・ イオン化ディテクタ ・ ロックイン、A/Dコンバータ等用プリアンプ 	
<p>仕様</p>	<p>テスト条件</p> <p>ゲイン</p> <p>周波数応答性</p> <p>入力</p> <p>出力</p> <p>バイアス出力</p>	<p>電源電圧 $V_s = \pm 15V$、環境温度 $T_a = 25^\circ C$</p> <p>トランスインピダンス 1 x 10⁶ V/A (@ 50 Ω 負荷) 精度 ± 1 %</p> <p>下限カットオフ周波数 DC 上限カットオフ周波数 2 MHz (-3 dB) 立上り/立下り時間 180 ns (10 % - 90 %) ゲインフラットネス ± 0.3 dB</p> <p>等価入力ノイズ電流 3.5 pA/√Hz (@ 100 kHz) 等価入力ノイズ電圧 0.8 nV/√Hz (@ 100 kHz) 入力バイアス電流 18 μA typ. 入力バイアス電流ドリフト 0.8 nA / K オフセット電流補償 ± 6 μA、オフセットトリマポットにて調整可 入力電流レンジ ± 1.5 μA (リニア増幅域) 入力オフセット電圧 3 mV DC入力インピダンス 50 Ω (virtual) // 5 pF</p> <p>出力電圧 ± 1.5 V (@ 50 Ω 負荷) 線形増幅・高調波歪み抑制 出力インピダンス 50 Ω (50 Ω 負荷終端時最適性能)</p> <p>バイアス出力電圧レンジ ± 12 V バイアストリマポットにて調整可 バイアス出力インピダンス 10 kΩ // 1 μF</p>



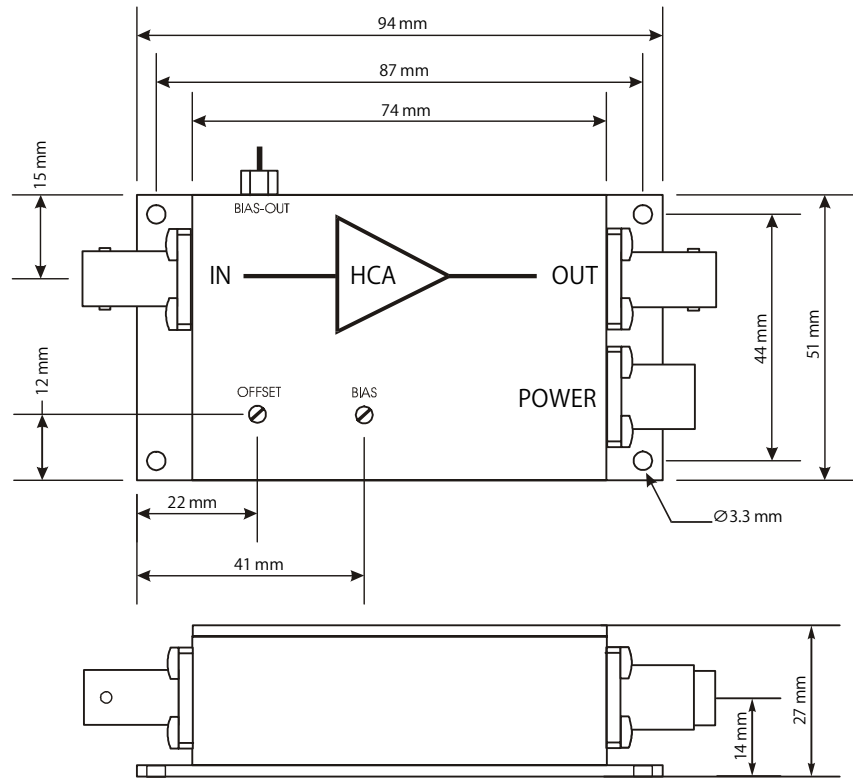
高速 電流アンプ

<p>仕様 (続き)</p> <p>電源入力</p> <p>ケース</p> <p>温度条件</p>	<p>電源電圧 ± 15 V</p> <p>電源電流 ± 50 mA typ. 動作条件により変動 推奨パワーサプライ能力 min. ±150 mA</p> <p>重量 210 g (0.5 ポンド)</p> <p>材質 AlMg4.5Mn、ニッケルメッキ</p> <p>保管温度 -40 °C ~ +100 °C</p> <p>動作温度 0 °C ~ +60 °C</p>
<p>絶対入力限界</p>	<p>信号入力電圧 ± 5 V</p> <p>瞬時高電圧 ± 3.5 kV (パルス幅 10 ns)</p> <p>電源入力電圧 ± 22 V</p>
<p>コネクタ</p>	<p>信号入力 BNC</p> <p>信号出力 BNC</p> <p>電源入力 Lemo 1Sシリーズ 3-pin (対応プラグタイプ: FFA.1S.303.CLAC52)</p> <p>Pin 1: + 15V</p> <p>Pin 2: - 15V</p> <p>Pin 3: GND</p> 



高速 電流アンプ

外径図



DZ01-0201-22